19日本国特件庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A) 昭64-19729

@Int.Cl.4 H 01 L 21/304

識別記号

庁内整理番号 A-7376-5F Z-7376-5F

母公開 昭和64年(1989)1月23日

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

図発明の名称 半導体ウェーハの製造方法

到特 願 昭62-175714

願 昭62(1987)7月14日

砂発 明 者 鬼崎

和則

佐賀県杵島郡江北町大字上小田2201番地 九州電子金属株 式会社内

砂発 明 者

正 晴

佐賀県杵島郡江北町大字上小田2201番地 九州電子金属株 式会社内

砂発 明 者

吉 春

哲二郎

正商

砂出 顋 九州電子金属株式会社 ⑪出 顋 人 大阪チタニウム製造株

式会社 弁理士 森 兵庫県尼崎市東浜町1番地 大阪チタニウム製造株式会社 佐賀県杵島郡江北町大字上小田2201番地

兵庫県尼崎市東浜町1番地

1 . 免明の名称

砂代 理 人

半導体ウエーハの製造方法

2. 特許請求の義関

1)スライスされた一枚の半導体ウエーハを、拡 **愚処理した後、房定厚さに仕上げる半導体**ウ エーハの製造方法において、新設処理した一枚 の辛有体ウエーハを切断装置により二分割にス ライズし、その検所定席さに仕上げることを特 徴とする未書体ウエーハの製造方法。

2) 蔚記半瘙体ウエーハを三分割にスライスする 以に、半連体ウエーハを安着支持する吸着無材 を前記切断装置により切断し、この切断所に半 孝体ウエーハを吸蓋支持して前記切断面を携準 **而として半導体ウエーハをスライズする特許期** 求の義原第1項記憶の半導体ウエーハの製造方

1]スライスされた一枚の半帯体クエーハを、拡 **長処理した後、所定厚さに仕上げる半週体製造** 力法において、 鉱骸処理した多数の学療体ウ

エーハを重ね合せて切断装置により一度に各半 3本ウエーハを2分割スライスし、その後所定 厚さに仕上げることを特徴とする半導体ウェー ハの製造方法。

3 . 発明の詳細な説明

〔唐末上の利用分野〕

未発明は、拡展処理後の拡散ウエーハの表示研 群長を頼夕させて参盟りよく本海体ウエーハを製 逝する半導体ウエーハの製造方法に関する。

(従来の技術)

従来、半導体ウエーハを製造する際は、第6月 に示すように、処理用ウエーハをスライスするエ 程S,,面取りする工程S,. ラッピングする 工程S。、エッチングする工程S。. 洗浄工程 S:、 钛散処理工程 S:、 研削工程 S, を發て 3 ラーポリシュ工程S。 たおいて仕上げることによ り、半導体ウエーハ(以下、ウエーハという)で 製造していた。また、鉱敷処理工程においてウ エーハの奔所が拡贴してしまうため、仕上げ段階 で研開、截面加工を行ない、ウエーハの片面を化

-187-

上呼みになるまで加工するのが一般的である。 (発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記従来の方法においては、スライス工程等を終たウエーハを拡散処理した後、研削工程やミラーボリッシュ工程において片所を 仕上げ序みとなるまで研磨しなければならないので、この研修中の加工代が多くなり、加工時間が かかるとともに原料費が増大する問題がある。

(問題点の解放手段および作用)

本是明は上記問題点を解決する半導体ウエーハの 製造方法を提供する目的でなされたものであり、下記技術手段を採用する。

すなわち、第1 塔明に係る製造方法は、スライスされた一枚の半滞体ウェーハを、拡散処理した 後、原定厚さに仕上げる半滞体ウェーハの製造 法であって、拡散処理した一枚の半導体ウェーハ を切断装置により三分割にスライスし、その後度 定厚さに任上げる構成としたものであり、した がって、拡散処理された半導体ウェーハが仕上り 厚みと傾痒加工化を表して半導体ウェーハを二分

3

上記分割切断工程S111においては、第2図に示す切断装置10を用いている。この切断装置10は、何転輪11上に半球状のハウラング12が固定され、このハウラング12の具盤部に固着された契持プレード13に所定内径の内筒刃14が履付けられており、同転輪11の回転により内局刃14が同転する。

また ハウジング12の中央上方には、第2回

対にスライスすることにより、 拡放半導体ウェー ハの研算量を減少でき、研磨時間の短線および以 料度を低級できる。

また、野2是明に係る製造力族は、スライスをれた一枚の半電体ウエーハを、制度処理したた後、原定厚さに仕上げる半導体製造方法であって、気管理した多数の半導体ウエーハを面和合せてススと、大型関により一度にお半導体ウエーハを力が表現という。大型の機能を関ることができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととができるととが呼ばれば、関係対象を開議することが可能となる。(実施例)

以下に木売明を図示の実施例に基づいて設明する。

本実施例では、第1回に示すフローチャートの 手順によりウエーハが製造される。すなわち、 切 所工程S いでは単計品シリコンインゴットを厚め のウエーハにスライスし、簡かり工程S いで切断

4

中の矢印A、Bで示すように、上下、水平に移動できるよう割出し狭智に連結された支持原材 1 5 が配設されている。支持部材 1 5 の下値にはカーボンよりなる柱状の吸む部材 1 6 が固設されている。この吸者部材 1 6 の内部にはシーフレックスチューブ 1 7 が限め込まれており、チェーブ 1 8 を通じて吸引数詞に連結されている。

5

-188-

8

特無464-19729(3)

更に、切断されたウエーハ20は、上述したように、研料工程 S_{10} において、日標序さとなるまで研解し、ミラーボリッシュにより仕上げられる。

したがって、分材切断工程において、目標序に近い浮さとなるようスライスされるので、此の部 終工程での加工代が少なくて終み、研修時間の短 終されるとともに、切構されたウエーハの再利用 を図ることにより原料機の浪費を低減することが できる。

また、上記分割切断する際に、第3図(a)、(b) に示すように、基準価を設定することにより行なうことができる。この場合には、クエーハ切断に先たって、第3図(a) に示すように受着部材1 6の下端値を内隔刃1 4により切断する。これにより切断面が内隔刃1 4に対し平行となるので、これを基準にしてこの携性値にウエーハ20をがって、切断されるウエーハ20の板厚を均一なものとすることができる。この場合、割出し継続に

7

せたウェーハ20を一度にスライスできるように 欠白25上方に配設された複数のワイヤ(企力 との 26と、 変わ25の一端側に関定的具27により 支持され系ね合せられたウエーハ20の実面との 行に設置された非接触式うず電池センの投数で と、 複数のワイヤ25の向きを合わせる位数を と、 複数のワイヤ25の向きを合わせる位数を を、 複数のワイヤ25の向きを合わせる 位数で を、 複数のワイヤ25の向きを合わせる で を下降させることにより、 多数枚のウエーハ20 を下降させることにより、 多数枚のウエー ある。

この切断変数ではワイヤ26の切込み運動面と、 ウエーハ2分割位置とを平行に調整できるセンサー28により多数枚を一度に2分割切断を行なうのでおウエーハ20の板原精度を向上できるとともに、作実時間の短縮化が図られる。

(以下余白)

で戻し量では、で=(x~y)/2となり、2分 関ウエーハの原みとなる。尚、xはウエーハの数 厚、yは対耳(切代を含む)である。

時、上記分割切断工程での切断契数としては、 第4回および第5回に示す装置22、24を利用 することもできる。

第4 図(a),(b) に示す切断数数222は、吸着部材16 に吸着されたウエーハ20の下間に同い (a),(b) に示すように複数の非接触式釘&型センサー23 を取付け、これらのセンサ23を用いて内層列14に平行になるよう関中の矢向以外で示す方向に結晶値を世機構により平行度調整を行なうとともに、センザー23 にて内周列レードと拡展ウエーハの距離を測定し、測定側によりウエーハ20のスライス位置を設定して分割するものであり、スライス時のウエーハ板序の拮底を向上できる。

第5回(a),(b) に示す切断発置24は、拡散処理されたウエーハ20を多数枚重ねて貼り合せたちのを複置きに固定する接着架合25と、重ね合

8

	ENDER	A LICE	MIST DEFICE TO	KAK Compa	E .	等 学 子 子 子	H-5% An IL to	PRANT'S	TANKE BERKER
REFE	300 p.s.	300 mm 80 mm	## (Q)	C W H	8	185.08	585 ±=√8≹	■ 7 0.0c	#3
	UNDERS IN CH	357 B) JACER	201 to 10,000 as acted acceded acceded acceded accession	ACAR ELFERS	A 2554 DE BREEF	多 第二	一种加工代	STANKE.	TONE BENEED
MINUSTERS INFO		■+f 0.9	10,40		308 ₩■	145 # 8	#15 µ ± 22.5 µ ± 24.5 µ ± 24.	300 μ	244
	UNDANA Antiet	河西	The state and the second should be second should be second should be second should be second should	拿	25XNHVIII BSALCH	和歌 拉工代	HWALLER	TENE E	G ERTO
TUSKED 440	200	a 7 09	40 pm	n	200 mm	15 με	595 mw 20x - 297.5 mw/dx	300	2 tk /#3

9

--189--

ğ

特圍場54-19729 (4)

未発明者らが内四刃による場合と、 政刃による **場合について試験した薪集、別宴に示すように呑** 1.税での加工化が開設の如く得られた。すなわ ち、ウエーハの日標序さが 300 μョの場合、切断 時から研磨時に至るトークル加工代が、従来の方 非によれば −枚当り 585±± であるのに対し、内 周後による二分類切断によれば…枚当り 422.5 μ a となり、また衣刃によれば -- 枚当り 297.5 μ в となり、従来に比べて加工代を大幅に減少さ せることができた。

(発明の効果)

単上説明したように未発明によれば、研究時の 加工代が少なくできるので、 研疫時の研究時間の 近蘇化を図ることができ、これに伴って旋料性が 仇賊する。また、多数の半導体ウエーハを阿幹に 分材することができるので、更に半速体ウエーハ の製造工程の知論化を図ることができ、歩層りを 向上することが可能となる。

4 - 団間の簡単な説明

1 1

り、第1団は半導体ウエーハの製造処理を示すっ ローチャート、第2回は分割切断装置の概略例、 第3間(a),(b) は木桑明の郎2実施例に係る分解 切損装置の動作を説明する概略図、 第4間 (a)、 (b) は未発明の第3実施術に係る分解切断能器の 鬼幣図およびセンサの配置調査を示す平前図、 駅 5 図(a).(b) は太兇朝の郎 4 実施例に係る分割切 新装置を示す正面図および側面図、路も図は従来 の製造工程を示すフローチャート。

10,22,24... 切陶装置 15・・・ 吸着部材 20・・・ 半導体ウエーハ Signo 数數処理工程

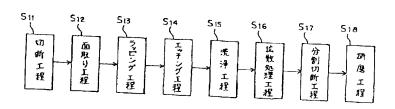
特許出願人 九州電子食匠株式会社

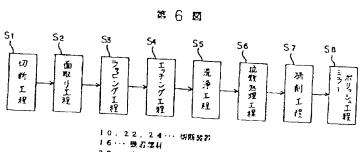
特許出願人 大阪チタニウム製造株式会社

作 痩 人 升理士 ìE. 70

1 2

第 1 図

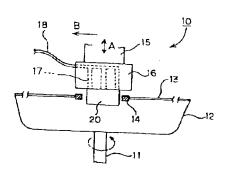




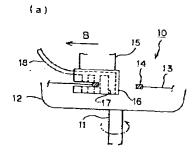
20… 半導体ウエーハ 512... 拡散処理工程

-190 -

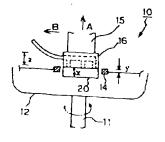
第 2 図



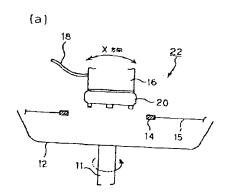
第 3 図



۲Ь١

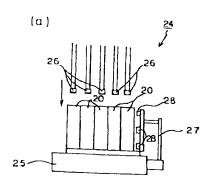


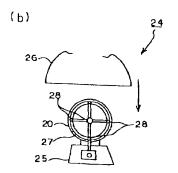
第 4 図



-191-

第 5 🛭





-192**-**

....